

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: a 2020 0054 (22) Data depozit: 2020.06.09 (71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (54) Titlu: Procedeu de obținere a fotodetectorului de radiație infraroșie în baza nanofirului de GaAs		
II. Clasificarea obiectului invenției: (51) Int.Cl: <i>B82B 1/00</i> (2011.01) <i>H01L 21/3063</i> (2006.01) <i>B82B 3/00</i> (2011.01) <i>H01L 31/08</i> (2006.01) <i>B82Y 40/00</i> (2011.01) <i>H01L 31/09</i> (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stânga/dreapta): B82B 1/00, H01L 21/3063, B82B 3/00, H01L 31/08, B82Y 40/00, H01L 31/09, procedeu, obține, confecționa, bolometru, fotodetector, detector, radiație infraroșie, nanofir, GaAs, arseniură de galiu, contact ohmic "Worldwide" (Espacenet), PatSearch: B82B 1/00, H01L 21/3063, B82B 3/00, H01L 31/08, B82Y 40/00, H01L 31/09, process, method, obtain, manufacture, bolometer, photodetector, detector, infrared radiation, nanowire, GaAs, gallium arsenide, ohmic contact EA, CIS (Eapatis), SU: B82B 1/00, H01L 21/3063, B82B 3/00, H01L 31/08, B82Y 40/00, H01L 31/09, процесс, способ, получение, изготовление, болометр, фотоприемник, детектор, инфракрасное излучение, нанонить, GaAs, арсенид галлия, омический контакт		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
www.google.com		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate și, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	X. Chen, D. Wang, T. Wang, Z. Yang, X. Zou, P. Wang, W. Luo, Q. Li, L. Liao, W. Hu, Z. Wei. "Enhanced Photoresponsivity of a GaAs Nanowire Metal-Semiconductor-Metal Photodetector by Adjusting the Fermi Level", ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 36, 33188-33193	1
A, D, C	C. G. Nunez, A. F. Brana, N. Lopez, J. L. Pau, B. J. Garcia. Single GaAs nanowire based photodetector fabricated by dielectrophoresis. Nanotechnology, 2020, 31, 225604	1
A	US 2011168894 A1 2011.07.14	1
A	US 7256466 B2 2007.08.14	1
A	US 8232517 B2 2012.07.31	1
A	U. Frank, A. Brandl, W. Prettl. Far-infrared radiation controlled chaos in n-GaAs. Solid State Communications, Volume 69, Issue 9, 1989, Pag. 891-894	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se	

	bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării, 2023.05.17	
Examinatoare, SĂU Tatiana	Document semnat digital